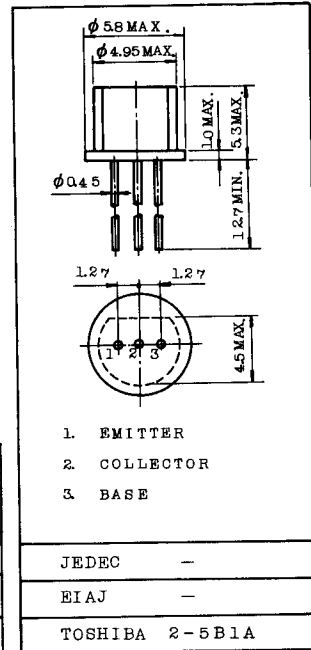


- 励振段増幅用
- 電圧増幅用
 - o Driver Stage Amplifier Applications
 - o Voltage Amplifier Applications
- 高耐圧です ; $V_{CE0}=50V$
- 飽和電圧が低い ; $V_{OE(sat)}=0.25V$ (Max.)
- 2SA561 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SA561

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	70	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	150	mA
エミッタ電流	I_E	-150	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合温度	T_j	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 125	$^\circ C$

Unit in mm



※ PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

2SC734

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

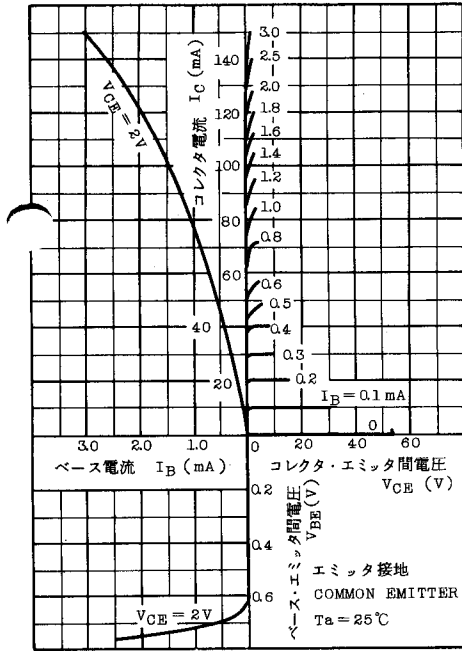
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 18V$ $I_E = 0$	-	-	0.1	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V$ $I_C = 0$	-	-	0.1	μA
直流電流増幅率 (Note)	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 1V$ $I_C = 20mA$	70	-	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 5V$ $I_C = 150mA$	23	-	-	
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 6V$ $I_E = -10mA$	-	150	-	MHz
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100mA$ $I_B = 10mA$	-	-	0.25	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 1V$ $I_C = 100mA$	-	0.75	1.0	V
コレクタ出力容量	C_{Ob}	$V_{CB} = 6V$ $I_E = 0$ $f = 1MHz$	-	5	-	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ および $h_{FE(2)}$ により下表のように分類し現品表示してあります。

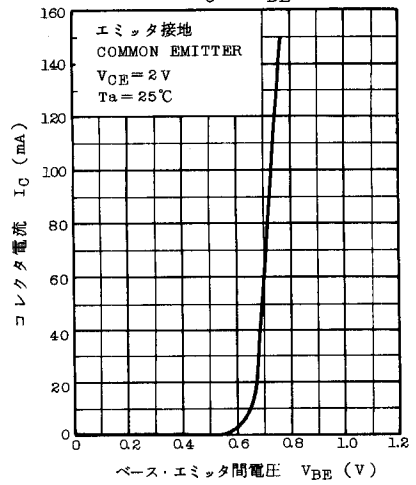
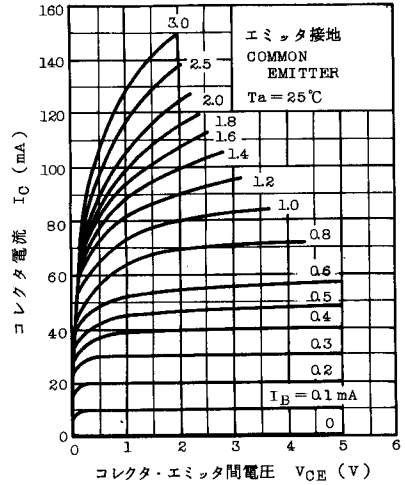
According to the value of $h_{FE(1)}$ and $h_{FE(2)}$, the 2SC734 is classified as follows.

CLASSIFICATION	$h_{FE(1)}$		$h_{FE(2)}$
	MIN.	MAX.	MIN.
2SC734-0	70	140	23
2SC734-Y	120	240	40
2SC734-GR	200	400	67

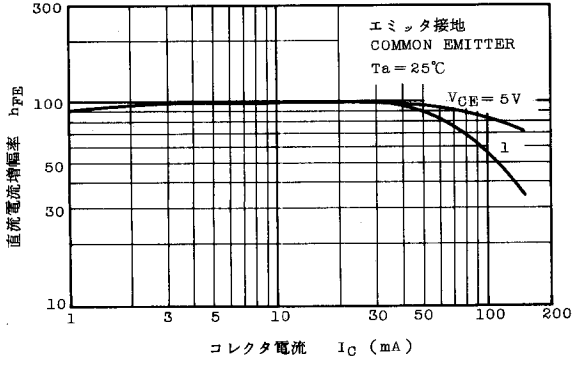
STATIC CHARACTERISTICS



$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



$h_{FE} - I_C$



$P_C - T_a$

